汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

H1270

对应国外型号
KTA1270

主要用途

音频小功率放大、驱动级、开关应用。

外形图及引脚排列

TO-92

1—发射极，E
2—集电极，C
3—基　极，B

极限值（T_a=25℃）

T_{stg}——贮存温度…… -55~150℃

T_j——结温……150℃

P_C——集电极耗散功率……500mW

V_{CBO}——集电极—基极电压……-35V

V_{CEO}——集电极—发射极电压……-30V

V_{EBO}——发射极—基极电压……-5V

I_C——集电极电流……-500mA I_B

——基极电流……-100mA

电参数（T_a=25℃）

参数符号	符　号　说　明	最小值	典型值	最大值	单 位	测　试　条　件
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-100	nA	V_{CB}=-35V, I_E=0
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-100	nA	V_{EB}=-5V, I_C=0
H_{FE} (1)	直流电流增益	70		240		V_{CE}=-1V, I_C=-100mA
H_{FE} (2)		25				V_{CE}=-6V, I_C=-400mA
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压		0.1	-0.25	V	I_C=-100mA, I_B=-10mA
$V_{BE(on)}$	基极—发射极导通电压		0.8	-1.0	V	V_{CE}=-1V, I_C=-100mA
f_T	特征频率		200		MHz	V_{CE}=-6V, I_C=-20mA
Cob	共基极输出电容		13		pF	V_{CB}=-6V,I_E=0, f=1MHz

分档及其标志

O	Y
70—140	120—240